

Учебный план основной образовательной программы

Микро-и наноэлектроника (реализуется совместно с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники)

по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»

Уровень: Магистратура
Квалификация: магистр
очная форма обучения
2023 год приема

План одобрен учебно-методическим советом института (факультета).
Протокол №03/3-21 от 31.08.2021

1. График учебного процесса

		Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август																																								
		1-7 сент.	8-14 сент.	15-21 сент.	22-28 сент.	29 сент.-5 окт.	6-12 окт.	13-19 окт.	20-26 окт.	27 окт.-2 нояб.	3-9 нояб.	10-16 нояб.	17-23 нояб.	24-30 нояб.	1-7 дек.	8-14 дек.	15-21 дек.	22-28 дек.	29 дек.-4 янв.	5-11 янв.	12-18 янв.	19-25 янв.	26 янв.-1 фев.	2-8 фев.	9-15 фев.	16-22 фев.	23 фев.-1 марта	2-8 марта	9-15 марта	16-22 марта	23-29 марта	30 марта-5 апр.	6-12 апр.	13-19 апр.	20-26 апр.	27 апр.-3 мая	4-10 мая	11-17 мая	18-24 мая	25-31 мая	1-7 июня	8-14 июня	15-21 июня	22-28 июня	29 июня-5 июля	6-12 июля	13-19 июля	20-26 июля	27 июля-2 авг.	3-9 авг.	10-16 авг.	17-23 авг.	24-30 авг.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Годы	1																					Э	Э	Э	К	Т	Т	Т	Т	Т	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П			
	2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	К	Т	Т	Т	Т	Т	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П		
	3	К	К	К	К																																																
		Т – теоретическое обучение, Э – экзаменационная сессия, К – каникулы, П – практика, Д – выпускная квалификационная работа																																																			

Метка	Название	Структурное подразделение	ЗЕТ	ч	Семестры																								Практическая подготовка	Компетенции							
					1 курс										2 курс										3 курс												
					1 14 нед (ТО: 14 нед)					2 19 нед (ТО: 19 нед)					3 18 нед (ТО: 18 нед)					4 4 нед (ТО: 4 нед)					5												
					Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт			Ауд	Лек	Пр	Лаб	СРС	Атт	
Б1.ДВ.2.3 Ф	Элементы нанoeлектроники	67	3	108							52	26	26		56	3																					ПК-9
Б1.ДВ.2.4 Ф	Б1.ДВ.2.4.1 Проектирование гибридных микросборок	27	3	108							52	24		28	20	Э(36)																				ПК-1, ПК-11, ПК-7.2	
	Б1.ДВ.2.4.2 Физика и технология приборов микро- и нанoeлектроники	67																																			
Б1.ДВ.2.5 Ф	Схематехническое и топологическое проектирование в нанoeлектронике	67	3	108	60	24				36	12	Э(36)																								ПК-2	
Б1.ДВ.2.6 Ф	Б1.ДВ.2.6.1 Информационное обеспечение управления рисками инновационных технологий	67	3	108							48	16		32	60	3																				ПК-3, УКЦ-1	
	Б1.ДВ.2.6.2 Защита электронных устройств от внешнего электромагнитного излучения																																				ПК-3, ПК-4
Б1.ДВ.2.7 Ф	Б1.ДВ.2.7.1 Организация и элементная база интернета вещей	67	3	108							48	24	24		60	3																				ПК-2	
	Б1.ДВ.2.7.2 Основы радиационной стойкости полупроводниковых приборов				3																																
Б2	Практика		41	1476																																	
Б2.ОД	Базовая часть		5	180																																	
Б2.ОД.1 О	Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)	27	5	180														32				112	Э(36)													108	ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17
Б2.ДВ	Вариативная часть		36	1296																																	
Б2.ДВ.1 Ф	Производственная практика (научно-исследовательская работа)	27	12	432							30				186	3	30					186	3													288	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УКЦ-1, УКЦ-2, ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4
Б2.ДВ.2 Ф	Производственная практика (преддипломная)	27	24	864																								864	3							432	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, ПК-7.4
Б3	Государственная итоговая аттестация		6	216																																	

